

Изобретение относится к отрасли получения монокристаллов полупроводниковых материалов, в частности к подготовке тиглей для выращивания монокристаллов кремния из расплава по методу Чехральского. Предложенный способ включает формирование барийсодержащего покрытия из гидроксида бария на внутренней и/или внешней поверхности нагретого до температуры 100-150 °С кварцевого тигля. Изобретение позволяет улучшить равномерность и однородность покрытия, которое приводит к увеличению выхода пригодного продукта и снижению нехватки при получении слитков кремния монокристалла.